

**Сводный перечень статей, опубликованных в журнале
"Прикладная физика" в 2014 г.**

	Номер выпуска	Стр.		Номер выпуска	Стр.
ОБЩАЯ ФИЗИКА					
<i>Антилов А. М., Бархударов Э. М., Кос- ский И. А., Лукьянчиков Г. С., Миса- кян М. А., Моряков И. В.</i> Тонкая нано- структурированная углеродная плёнка на поверхности металла как способ предотвращения мультипакторного разряда	4	11	<i>Морозов А. Н., Скрипкин А. В.</i> Стати- стическое описание флуктуаций тока через конденсатор с приложенным к нему случайным напряжением	3	5
<i>Барбин Н. М., Овчинникова И. В., Те- рентьев Д. И., Алексеев С. Г.</i> Термоди- намическое моделирование термических процессов, происходящих в расплавлен- ном сплаве Вуда при различных условиях	3	8	<i>Роках А. Г., Шишкин М. И., Вениг С. Б., Матасов М. Д., Аткин В. С.</i> Аналогии между экзоэлектронной фотоэмиссией и вторично-ионным фотоэффектом в полупроводниках	5	11
<i>Барбин Н. М., Туркина И. В., Теренть- ев Д. И., Алексеев С. Г.</i> Термодинамиче- ское моделирование паровой фазы при испарении расплавленного сплава Вуда при различных давлениях	3	12	<i>Романов А. В., Степович М. А., Филип- пов М. Н.</i> Модель процесса генерации спектров вторичной флуоресценции конденсированного вещества	6	16
<i>Бычков С. С., Бычков-мл. С. С., Мора- лев И. А., Пятницкий Л. Н., Третьяко- ва Н. В.</i> Воздействие плазмы, индуци- рованной лазерным бесселевым пуч- ком, на воздушный вихрь	2	10	<i>Славкин В. В., Тищенко Э. А.</i> Изучение вихревой структуры поликристалличе- ских $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ -соединений с помо- щью дифференциальной магнитной восприимчивости	2	5
<i>Войцеховский А. В., Горн Д. И.</i> Лазерная генерация в структурах КРТ с кванто- выми ямами	5	5	ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ		
<i>Голятина Р. И., Майоров С. А.</i> Расчет характеристик переноса электронов в смеси гелия с ксеноном	4	5	<i>Аксинин В. И., Казанцев С. Ю., Коно- нов И. Г., Кудрявцев Е. М., Орлов А. А., Подлесных С. В., Фирсов К. Н., Хороз- ова О. Д.</i> Конверсия SiF_4 во фторсиланы и моносилан в плазме объемного само- стоятельного разряда	1	5
<i>Гришечкин М. Б., Денисов И. А., Сили- на А. А., Смирнова Н. А., Шматов Н. И., Яковенко А. Г.</i> Исследование дефектов структуры в кристаллах $CdZnTe$ мето- дами инфракрасной и оптической мик- роскопии	6	9	<i>Александров А. Ф., Вавилин К. В., Краль- кина Е. А., Неклюдова П. А., Павлов В. Б.</i> Исследование параметров плазмы ВЧ- индуктивного источника плазмы диа- метром 46 см. Часть II. Математическое моделирование параметров плазмы ин- дуктивного и гибридного ВЧ-разрядов	1	9
<i>Котов В. М.</i> Акустооптическая моду- ляция многоцветного излучения с про- порциональным изменением интенсив- ности световых волн	6	5	<i>Александров А. Ф., Вавилин К. В., Краль- кина Е. А., Неклюдова П. А., Павлов В. Б.</i> Исследование параметров плазмы ин- дуктивного ВЧ-источника плазмы диа- метром 46 см. Часть III. Эффективность вложения мощности	2	17
<i>Крылов В. И., Хомяков В. В.</i> Тормозное излучение нерелятивистских электро- нов, пронизывающих многослойную упорядоченную систему кулоновых центров при наличии внешнего элек- трического поля	2	13	<i>Андреев В. В.</i> Исследование воздейст- вия диэлектрического барьерного раз- ряда на кремнийсодержащую плёнку	6	24
<i>Логунов М. В., Неверов В. А., Мамин Б. Ф.</i> Исследование структурных неоднород- ностей карбида кремния методом мало- углового рентгеновского рассеяния	5	15	<i>Андреев В. В., Васильева Л. А., Пичу- гин Ю. П.</i> Исследование энергетиче- ской цены синтеза озона в ячейках по- верхностного диэлектрического барь- ерного разряда	3	43
<i>Мамедов Н. А., Гарибов Г. И., Алекбе- ров Ш. Ш., Расулов Э. А.</i> Изменение поверхностного натяжения воды под действием различных физических фак- торов	6	20	<i>Андреев В. В., Матюнин А. Н., Пичу- гин Ю. П.</i> Плазмохимический генератор озона с повышенной однородностью микроразрядных процессов в барьер- ном разряде	3	39
<i>Мелкумян Б. В.</i> Изменение моды при движении фазового скелета излучения	3	17	<i>Андреев С. Е., Ульянов Д. К.</i> Метод управления спектром плазменного ре- лятивистского СВЧ-генератора в час- отно-периодическом режиме	4	26
<i>Морозов А. Н., Скрипкин А. В.</i> Диффу- зия ионов в электролите под действием случайного тока	4	16	<i>Асюнин В. И., Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Козловская Т. И., Пиеничный А. А., Якубов Р. Х.</i> Некоторые особенности динамики плазмы дугового разряда в неоднородном магнитном поле	6	29

	Номер выпуска	Стр.		Номер выпуска	Стр.
<i>Ашурбеков Н. А., Иминов К. О., Рамазанов А. Р., Шахсинов Г. Ш.</i> Исследование процессов формирования периодической плазменной структуры в импульсных наносекундных электрических разрядах	2	29	<i>Кузенов В. В., Рыжков С. В., Шумаев В. В.</i> Определение термодинамических свойств замагниченной плазмы на основе модели Томаса–Ферми	3	22
<i>Балданов Б. Б., Ранжуров Ц. В.</i> Изменение контактных свойств поверхности пленок политетрафторэтилена, модифицированных в плазме слаботочного поверхностного разряда	2	26	<i>Курбанисмаилов В. С., Омаров О. А., Рагимханов Г. Б.</i> Излучательные и спектральные характеристики искрового канала в аргоне	3	35
<i>Балмашинов А. А., Степина С. П., Умнов А. М.</i> Параметры ЭЦР-плазмы, формируемой в узком коаксиальном резонаторе плазменного инжектора CERA-RI-2	3	31	<i>Пляка П. С., Алихаджиев С. Х., Толмачев Г. Н.</i> Исследование пылевых частиц, образующихся при распылении сложного оксида в кислородном высокочастотном разряде	5	19
<i>Бардаков В. М., Иванов С. Д., Казанцев А. В., Строкин Н. А.</i> К вопросу о реализации плазмооптической масс-сепарации	1	12	<i>Семенов А. П., Балданов Б. Б., Ранжуров Ц. В., Норбоев Ч. Н., Намсараев Б. Б., Дамбаев В. Б., Гомбоева С. В., Абидуева Л. Р.</i> Воздействие низкотемпературной аргоновой плазмы слаботочных высоковольтных разрядов на микроорганизмы	3	47
<i>Богачев Н. Н., Богданкевич И. Л., Гусейн-заде Н. Г.</i> Моделирование режимов работы плазменной антенны	4	30	<i>Смоланов Н. А., Панькин Н. А., Батин В. В., Павкин Е. П.</i> Структура и некоторые свойства пылевых частиц из плазмы дугового разряда	1	30
<i>Боровской А. М.</i> Моделирование течения газа с учётом нагрева в цилиндрических каналах высоковольтных плазмотронов переменного тока	4	40	<i>Тазмеева Р. Н., Тазмеев Б. Х.</i> Экспериментальное исследование массового уноса жидкого электролитного катода под воздействием газового разряда	1	35
<i>Боровской А. М.</i> Моделирование течения холодного плазмообразующего газа в цилиндрических каналах высоковольтных плазмотронов переменного тока	2	21	ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИОННЫЕ И ЛАЗЕРНЫЕ ПУЧКИ		
<i>Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Панов В. А., Печеркин В. Я., Сон Э. Е.</i> Электрический пробой при растекании импульсного тока в песке	4	20	<i>Балмашинов А. А., Калашиников А. В., Калашиников В. В., Степина С. В., Умнов А. М.</i> Самоорганизация сгустков электронов в ЭЦР-источнике рентгеновского излучения CERA-RX(C)	3	51
<i>Герман В. О., Глинов А. П., Головин А. П., Козлов П. В.</i> О влиянии внешнего магнитного поля на устойчивость электродугового разряда	4	35	<i>Иванов В. С.</i> Практика распараллеливания вычислений при моделировании электронно-оптических систем	2	33
<i>Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Козловская Т. И., Ревазов В. О., Селезнев В. П., Якубов Р. Х.</i> Процесс коммутации вакуумного электроразрядного промежутка лазерной плазмой	6	32	<i>Крылов В. И., Хомяков В. В.</i> Тормозное излучение электронов, проходящих через многослойную структуру кулоновых центров и ускоряемых электрическим полем	5	29
<i>Ернылева С. Е., Лоза О. Т.</i> Конфигурации импульсно-периодических плазменных релятивистских СВЧ-генераторов	1	17	<i>Кулиш В. В., Лысенко А. В., Алексеенко Г. А., Коваль В. В., Ромбовский М. Ю.</i> Супергетеродинные плазменно-пучковые ЛСЭ с винтовыми электронными пучками	5	24
<i>Иванов В. А., Коныжев М. Е., Дорофеев А. А., Камолова Т. И., Куженова Л. И., Лаптева В. Г., Хренникова И. А.</i> Создание прочного микрорельефа на поверхности стали-45 с помощью микроплазменных разрядов	6	38	<i>Чебан А. Ю., Хрунина Н. П., Леоненко Н. А.</i> Результаты экспериментальных исследований по резанию карбонатных горных пород мощным лазерным излучением	5	34
<i>Иванов В. А., Коныжев М. Е., Зимин А. М., Тройнов В. И., Камолова Т. И., Летунов А. А.</i> Измерение электронной температуры в микроплазменных разрядах, развивающихся на поверхности титана при импульсном электрическом токе 100 А	1	21	ФОТОЭЛЕКТРОНИКА		
<i>Кузенов В. В., Рыжков С. В.</i> Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле	3	26	<i>Абдинов А. Ш., Мехмиев Н. М., Бабаева Р. Ф., Рзаев Р. М.</i> Многофункциональные фотоприемники на основе кристаллов <i>n</i> -InSe	6	76
			<i>Акимов В. М., Андреев Д. С., Демидов С. С., Иродов Н. А., Климанов Е. А.</i> Вольтамперные характеристики фотодиодов матрицы фоточувствительных элементов планарного типа на основе структуры <i>p</i> -InP/InGaAs/ <i>n</i> -InP	5	50

	Номер выпуска	Стр.		Номер выпуска	Стр.
<i>Акимов В. М., Васильева Л. А., Демидов С. С., Климанов Е. А.</i> Методы редактирования топологии БИС считывания	2	37	<i>Войцеховский А. В., Несмелов С. Н., Дзядух С. М., Васильев В. В., Варавин В. С., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Кузьмин В. Д., Ремесник В. Г., Сидоров Ю. Г.</i> Исследование полной проводимости МДП-структур на основе варизонного МЛЭ $n\text{-HgCdTe}$ ($x = 0,22\text{—}0,23$ и $0,31\text{—}0,32$) в широком диапазоне температур	4	56
<i>Андреев Д. С., Гришина Т. Н., Мищенко Т. Н., Трищенко М. А., Чинарева И. В.</i> Формирование общего контакта в мезапланарных матрицах фоточувствительных элементов на основе гетероэпитаксиальных структур InGaAs/InP	4	90	<i>Войцеховский А. В., Несмелов С. Н., Дзядух С. М., Васильев В. В., Варавин В. С., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Кузьмин В. Д., Ремесник В. Г., Сидоров Ю. Г.</i> Особенности адмиттанса МДП-структур на основе варизонного МЛЭ $p\text{-HgCdTe}$ ($x = 0,22\text{—}0,23$)	4	62
<i>Андреев Д. С., Болтарь К. О., Власов П. В., Лопухин А. А.</i> Матричные фоточувствительные элементы на основе планарных фотодиодов из гетероэпитаксиальной структуры InGaAs/InP	1	47	<i>Гришечкин М. Б., Денисов И. А., Силина А. А., Смирнова Н. А., Шматов Н. И.</i> Исследование условий выращивания монокристаллов $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ ($x \leq 0,04$) методом вертикальной направленной кристаллизации по Бриджмену	5	72
<i>Андреев Д. С., Будтолаева А. К., Огнева О. В., Чинарева И. В.</i> Влияние плазмохимической обработки на электрические свойства фотодиодов на основе гетероструктур InGaAsP/InP	3	79	<i>Демидов С. С., Климанов Е. А.</i> Влияние параметров границы раздела полупроводник-диэлектрик на ток охранного кольца кремниевых фотодиодов	4	68
<i>Андреев Д. С., Будтолаева А. К., Хакуашев П. Е., Чинарева И. В.</i> Влияние диффузии серы из подложки InP гетероэпитаксиальной структуры InGaAs/InP на параметры pin -фотодиодов	3	75	<i>Демидов С. С., Климанов Е. А., Нури М. А.</i> Кремниевый координатный фотодиод с улучшенными параметрами	4	73
<i>Андреев Д. С., Лопухин А. А., Хакуашев П. Е., Чинарева И. В.</i> Исследование темновых токов в матрицах из InGaAs/InP кремниевых фотодиодов	1	74	<i>Демидов С. С., Климанов У. А., Колесникова Т. Г., Смирнов А. А.</i> Влияние примесей переходных элементов на темновые токи	1	68
<i>Балиев Д. Л., Лазарев П. С., Болтарь К. О.</i> Исследование фотоэлектрических параметров фотоприемного модуля формата 320×256 на основе InGaAs	5	54	<i>Ильинская Н. Д., Карандашев С. А., Карпухина Н. Г., Лавров А. А., Матвеев Б. А., Ременный М. А., Стусь Н. М., Усикова А. А.</i> Диодные матрицы формата 3×3 на основе одиночных гетероструктур $p\text{-InAsSbP}/n\text{-InAs}$	6	47
<i>Балиев Д. Л., Болтарь К. О., Власов П. В., Киселева Л. В., Ложников В. Е., Лопухин А. А., Мансветов Н. Г., Полунеев В. В., Рудневский В. С., Савостин А. В.</i> Матричное фотоприемное устройство на основе антимонида индия формата 640×512 с шагом 15 мкм	2	41	<i>Каиуба А. С., Головин С. В., Болтарь К. О., Пермикина Е. В., Атрашков А. С.</i> Исследование влияния термообработки на электрофизические характеристики эпитаксиальных слоев гетероструктур теллурида кадмия-ртути	4	76
<i>Болтарь К. О., Власов П. В., Ерошенков В. В., Лопухин А. А.</i> Исследование фотодиодов с токами утечки в матричных фотоприемниках на основе антимонида индия	4	45	<i>Каиуба А. С., Пермикина Е. В., Головин С. В.</i> Исследование поверхности эпитаксиальных гетероструктур $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ после полирующего травления	5	67
<i>Болтарь К. О., Власов П. В., Лопухин А. А., Мансветов Н. Г.</i> Характеристики охлаждаемой диафрагмы МФПУ среднего инфракрасного диапазона спектра	3	67	<i>Козлов К. В., Бычковский Я. С., Кондюшин И. С., Матвеев А. В., Соляков В. Н., Пожидаетев Д. А., Балиев Д. Л.</i> Установка измерения основных параметров многорядных матричных ФПУ	2	64
<i>Бочков В. Д., Дрожников Б. Н., Кузнецов П. А., Козлов К. В., Соляков В. Н.</i> Особенности ФПУ с режимом ВЗН формата 1024×10 на основе КРТ	1	58	<i>Комков О. С., Фирсов Д. Д., Ковалишина Е. А., Петров А. С.</i> Спектральные характеристики поглощения в эпитаксиальных структурах на основе InAs при температурах 80 К и 300 К	4	93
<i>Бочков В. Д., Дрожников Б. Н., Кузнецов П. А., Козлов К. В., Соляков В. Н.</i> Метод исследования параметров ФПУ с ВЗН формата 1024×10 на основе КРТ	4	53	<i>Кононов М. Е., Полесский А. В., Хамидуллин К. А.</i> Фотоэлектрическая связь ультрафиолетового матричного фотоприемника и солнечных элементов с квантовыми точками	3	71
<i>Бурлаков И. Д., Денисов И. А., Сизов А. Л., Силина А. А., Смирнова Н. А.</i> Исследование шероховатости поверхности подложек CdZnTe различными методами измерения нанометровой точности	4	80			
<i>Войцеховский А. В., Коханенко А. П., Лозовой К. А.</i> Оптимизация ростовых условий для улучшения параметров фотоприемников и солнечных элементов с квантовыми точками	5	45			

	Номер выпуска	Стр.		Номер выпуска	Стр.
<i>Кортаев Е. Д., Яковлева Н. И., Мирофьянченко А. Е., Ляликов А. В.</i> Особенности гетероструктур InGaAs/InP, предназначенных для изготовления быстродействующих фотоприемных устройств коротковолнового диапазона ИК-спектра	6	60	<i>Седнев М. В., Смирнов Д. В., Степанюк В. Е.</i> Влияние параметров быстрого отжига на ВАХ фотодиодов на основе ГЭС GaN/AlGaN	2	59
<i>Костюк Б. А., Варавин В. С., Парм И. О., Ремесник В. Г., Сидоров Г. Ю.</i> Влияние плазмохимического травления и последующего отжига на электрофизические свойства CdHgTe	4	85	<i>Сизов А. Л., Мирофьянченко А. Е., Ляликов А. В., Яковлева Н. И.</i> Кристаллографический анализ гетероэпитаксиальных структур теллурида кадмия-ртути	6	70
<i>Кузнецов П. А., Моцев И. С.</i> Построение БИС считывания с аналогово-цифровым преобразованием фотосигнала в ячейке матричных ФПУ длинноволнового ИК-диапазона	1	63	<i>Скребнева П. С., Бурлаков И. Д., Яковлева Н. И.</i> Исследование гетероэпитаксиальных структур CdHgTe методом спектроскопической эллипсометрии	5	61
<i>Лопухин А. А.</i> Влияние толщины фоточувствительных слоев на свойства МФПУ на основе антимонида индия	6	66	<i>Соляков В. Н., Козлов К. В., Кузнецов П. А.</i> Компьютерная модель процесса регистрации точечных источников излучения многорядными ФПУ с режимом ВЗН	2	54
<i>Лопухин А. А., Степанюк В. Е., Таубкин И. И., Фадеев В. В.</i> Исследование влияния светового отжига на свойства матричных фотоприемных структур на основе антимонида индия	6	56	<i>Холоднов В. А., Бурлаков И. Д., Другова А. А.</i> Аналитический подход к выбору оптимальной структуры лавинных гетерофотодиодов на основе прямозонных полупроводников	5	38
<i>Мадагов Р. С., Алекперов А. С., Гасанов О. М., Байрамов Р. Б.</i> Влияние атомов примеси Sm и гамма-излучения на спектры фотопроводимости слоистых монокристаллов GeS	5	76	<i>Яковлева Н. И., Болтарь К. О., Никонов А. В., Бункина Н. А.</i> Особенности спектральной зависимости поглощения эпитаксиальных структур CdHgTe	3	61
<i>Мирофьянченко А. Е., Кортаев Е. Д., Яковлева Н. И.</i> Исследование морфологии поверхности полупроводниковых подложек InSb, предназначенных для ИК-фотоэлектроники	3	55	<i>Яковлева Н. И., Болтарь К. О., Седнев М. В., Патрашин А. И., Иродов Н. А.</i> Матричные фотоприемные устройства коротковолнового инфракрасного диапазона спектра с лавинным усилением сигнала на основе гетероэпитаксиальных структур InGaAs	2	45
<i>Никифоров И. А., Никонов А. В., Болтарь К. О., Яковлева Н. И.</i> Исследование температурной зависимости диффузионной длины неосновных носителей заряда в эпитаксиальных слоях КРТ	6	52	ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ		
<i>Никонов А. В., Болтарь К. О., Яковлева Н. И.</i> Оптические свойства гетероэпитаксиальных слоёв AlGaIn	2	50	<i>Александров В. В., Бычковский Я. С., Дрожников Б. Н., Козлов К. В., Кондюшин И. С., Матвеев А. В.</i> Универсальная установка для контроля параметров электронных блоков, входящих в состав ФПУ	6	81
<i>Патрашин А. И., Бурлаков И. Д., Корнеева М. Д., Шабаров В. В.</i> Аналитическая модель для расчета параметров матричных фотоприемных устройств	1	38	<i>Асютин В. И., Давыдов С. Г., Долгов А. Н., Пшеничный А. А., Якубов Р. Х.</i> Управление динамикой плазмы в малогабаритном вакуумном разряднике с помощью однородного магнитного поля	2	72
<i>Полесский А. В., Самвелов А. В., Семенченко Н. А., Смирнов Е. А., Хамидуллин К. А.</i> Исследование влияния работы микрокриогенной системы интегрального типа на характеристики оптоэлектронных систем	1	83	<i>Балиев Д. Л., Бедарева Е. А., Деомидов А. Д., Полесский А. В., Сидорин А. В., Хамидуллин К. А., Юдовская А. Д., Цыганкова Г. М.</i> Автоматизированный стенд для измерения основных параметров МФПУ на основе InGaAs	6	93
<i>Роках А. Г., Шишкин М. И., Скапцов А. А., Пузыня В. А.</i> О возможности плазменного резонанса в пленках CdS-PbS в средней инфракрасной области спектра	5	58	<i>Бедарева Е. А., Горелик Л. И., Колесова А. А., Полесский А. В., Семенченко Н. А., Шкетов А. И.</i> Светосильный двухдиапазонный инфракрасный объектив	5	80
<i>Сахаров М. В., Астраускас Й. И.</i> Оценка эффективности решения информационных задач оптоэлектронной системой «смотрящего» типа с инфракрасным матричным фотоприёмным устройством в поле лазерного излучения	1	78	<i>Деомидов А. Д., Кононов М. Е., Полесский А. В., Семенченко Н. А., Хамидуллин К. А., Добрунов С. В.</i> Автоматизированная установка для исследования относительной спектральной характеристики матричного фотоприемного устройства ультрафиолетового диапазона спектра	6	87
<i>Седнев М. В., Болтарь К. О., Шаронов Ю. П., Лопухин А. А.</i> Ионно-лучевое травление для формирования мезоструктур МФПУ	4	51			

	Номер выпуска	Стр.		Номер выпуска	Стр.
<i>Железнов Ю. А., Малинский Т. В., Миколуцкий С. И., Токарев В. Н., Хасая Р. Р., Хомич Ю. В., Ямицков В. А.</i> Экспериментальная установка по микро- и наноструктурированию поверхности твердых тел лазерным излучением	3	83	<i>Свешников В. К., Базаркин А. Ф.</i> Моделирование работы выхода оксидного катода при воздействии натрия	2	76
<i>Котов В. М.</i> Модуляция многоцветного излучения Ag-лазера на основе акусто-оптической дифракции в кристалле парателлурита	2	69	<i>Тимошенко С. П., Кульчицкий А. Л.</i> Математическая модель управления МЛА с использованием метода пропорциональной навигации в программе МАТЛАБ	2	81
<i>Мелкумян Б. В.</i> Лазерный акселерометр на основе автономного резонаторного датчика	4	97	<i>Тиранов Д. Т., Гусева А. А., Филиппов В. Л.</i> Моделирование полей яркости объектов на фоне разорванной облачности атмосферы при наблюдении из нижней полусферы	5	85